

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-022407

(43)Date of publication of application : 21.01.2000

(51)Int.CI.

H01P 5/08

H01P 3/16

H01P 5/02

(21)Application number : 10-182064

(71)Applicant : KYOCERA CORP

(22)Date of filing : 29.06.1998

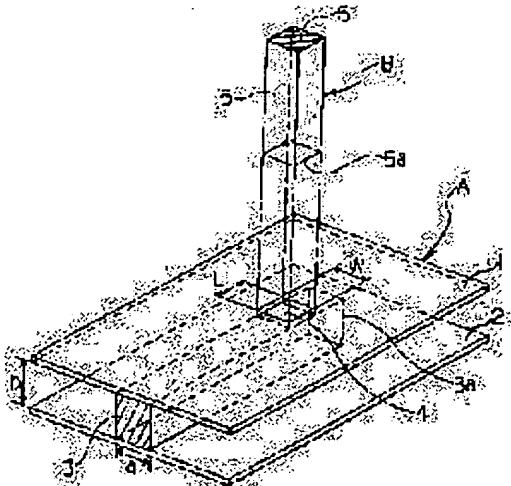
(72)Inventor : SATO AKINORI

## (54) CONNECTION STRUCTURE BETWEEN NRD GUIDE AND DIELECTRIC WAVEGUIDE

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a connection structure between a nonradioactive dielectric line NRD guide and a dielectric waveguide by which transmission with a small loss is attained even for a millimeter wave band of  $\geq 30$  GHz.

**SOLUTION:** The connection structure connects an NRD guide A formed by placing a dielectric line 3 between 1st and 2nd flat conductors 1, 2 to a dielectric waveguide B formed by filling a dielectric material in a conductor pipe, an open hole 4 is made for the conductor plate 1 at a position at which an electric field of a standing wave in the LSM mode is maximized in the NRD guide A, the open hole 4 and an open termination 5a of the dielectric waveguide B are connected or an open hole is formed for a side wall at a position placed from an end 5b of the dielectric waveguide B by 1/2 wavelength with respect to the waveguide wavelength and the open hole 4 of the NRD guide A and the open hole of the dielectric waveguide B are connected.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 20.05.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-22407

(P2000-22407A)

(43)公開日 平成12年1月21日(2000.1.21)

(51)Int.CL'

H01P 5/08  
3/16  
5/02

識別記号

607

F I

H01P 5/08  
3/16  
5/02

テ-マ-ド(参考)

K 5J014

607

## 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全5頁)

(21)出願番号

特願平10-182064

(22)出願日

平成10年6月29日(1998.6.29)

(71)出願人

000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田烏羽路町6番地

(72)発明者

佐藤 昭典

鹿児島県国分市山下町1番4号

京セラ株式会社総合研究所内

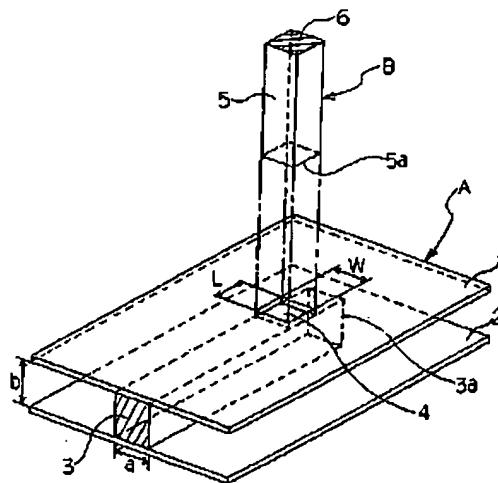
Fターム(参考) 5J014 DA03 HA06

(54)【発明の名称】 NRDガイドと誘電体導波管との接続構造

(57)【要約】

【課題】3.0GHz以上のミリ波帯でも、損失の小さい伝送が可能なNRDガイドと誘電体導波管との接続構造を提供する。

【解決手段】第1および第2の平板導体1、2間に誘電体隙陥3を配設してなるNRDガイドAと、導体管内に誘電体が充填された誘電体導波管Bとを接続する構造であって、NRDガイドA内のLSMモードの定在波の電界が最大になる箇所の第1の導体板1に開孔4を設け、開部4と誘電体導波管Bの開放終端部5aとを接続するか、あるいは誘電体導波管Bの終端5bから管内波長の1/2波長長さ位置の側壁に開孔7を設け、NRDガイドAの開孔4と、誘電体導波管Bの開孔7とを接続する。



(2)

特開2000-22407

2

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】第1および第2の平板導体間に誘電体線路を配設してなるN R Dガイドと、導体管内に誘電体が充填された誘電体導波管とを接続するための構造において、前記N R DガイドのL S Mモードの定在波の電界が最大になる箇所の前記第1の導体板に開孔を設け、該開孔と前記誘電体導波管の開放終端部とを接続することを特徴とするN R Dガイドと誘電体導波管の接続構造。

【請求項2】第1および第2の平板導体間に誘電体線路を配設してなるN R Dガイドと、導体管内に誘電体が充填された誘電体導波管とを接続するための構造において、前記N R DガイドのL S Mモードの定在波の電界が最大になる箇所の前記第1の導体板に開孔を設けるとともに、前記誘電体導波管の側壁に開孔を設け、前記N R Dガイドの開孔と、前記誘電体導波管の開孔とを接続することを特徴とするN R Dガイドと誘電体導波管の接続構造。

【請求項3】前記誘電体導波管の側壁に形成される開孔が、前記誘電体導波管の終端部から管内波長の1/2波長長さ位置に形成される請求項2記載のN R Dガイドと誘電体導波管の接続構造。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ミリ波集積回路等に組み込まれ、高周波信号の伝送用として用いられるN R Dガイドと誘電体導波管とを接続するための構造に関するものである。

【0002】

【従来技術】従来より、誘電体線路を1対の導体板によって挟持した単純な構造からなる非放射性誘電体線路

(以下、N R Dガイドといふ。)が高周波信号の伝送線路の1つとして用いられている。そして、このN R Dガイドを配線基板などに組入れる場合、回路設計上、このN R Dガイドを他の高周波用伝送線路と接続することが必要不可欠であり、その場合、伝送特性の劣化なく接続することが重要である。

【0003】そこで、他の高周波伝送線路との接続構造として、N R Dガイドと、マイクロストリップ線路と接続するための構造が提案されている。その一般的な構造を図6に示す。図6によれば、一対の導体板11、12の間に誘電体線路3が配設されたN R Dガイドにおける導体板11に、スロット孔13を形成し、そのスロット孔13の表面に、誘電体基板14表面に中心導体15が形成された基板をスロット孔13と中心導体15の終端部とが所定の位置関係になるように設置することにより、N R Dガイドと、マイクロストリップ線路とをN R Dガイドの導体板に設けられた導体板に開けられたスロット孔13を介して電磁的に接続するものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、回路設

10

計において高周波信号の周波数が30GHz以上のミリ波帯では、マイクロストリップ線路では伝送損失自体が大きくなるために、上記接続構造は信号周波数が30GHz以上である回路基板には向きであった。

【0005】このマイクロストリップ線路に代わり、30GHz以上のミリ波に対してもN R Dガイドと同様に伝送損失の小さい線路として誘電体導波管が知られており、回路設計においても誘電体導波管を用いることが必要となる。しかしながら、N R Dガイドと誘電体導波管との接続構造についてはこれまで全く報告がなかった。

【0006】従って、本発明は、30GHz以上のミリ波帯でも、損失の小さい伝送が可能なN R Dガイドと誘電体導波管との接続構造を提供することを目的とするものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明者は、第1および第2の平板導体間に誘電体線路を配設してなるN R Dガイドと、誘電体導波管とを伝送損失を小さく接続できる構造について検討を重ねた結果、N R Dガイド内の信号の電界の水平成分が最大となる箇所の前記第1の導体板に開孔を設け、該開孔と誘電体導波管の開放断面とを接続すること、あるいは前記誘電体導波管の終端から管内波長の1/2波長長さ位置の側壁に開孔を設け、前記N R Dガイドの開孔と、前記誘電体導波管の開孔とを接続することによって、前記目的が達成されることを見いたした。

【0008】

【発明の実施の形態】以下、本発明のN R Dガイドと誘電体導波管接続構造について、その概略斜視図である図3、図2をもとに説明する。

【0009】図1、図2に示すように、本発明のN R DガイドAは、一対の平行平板導体1、2間に、断面がa×bの誘電体線路3が配設されており、端部は開放終端部3'となっている。このような構造のN R DガイドAにおいては、図3に示すようなL S Mモードによる電界の定在波が生じる。

【0010】本発明においては、誘電体導波管Bとの接続用として、この定在波の電界の強い部分、即ち、図3におけるP1、P2、P3、P4のいずれかの箇所における導体板1に、P1～4の各箇所を中心とする開孔4を設ける。誘電体導波管Bとの回路設計の点からは、P1またはP2の箇所に開孔4を設けることが望ましい。

【0011】なほ、導体板1の開孔4内には、誘電体線路3と同程度の誘電率を有する誘電体を埋め込むことによって、誘電体導波管との損失の少ない接続が得られる。

【0012】一方、誘電体導波管Bは、断面が矩形状の金属の管5によって形成され、その内部には、誘電体6が埋め込まれている。

【0013】上記N R DガイドAと誘電体導波管Bと

40

50

(3)

特開2000-22407

4

3

は、N R D ガイド A における導体板 1 に設けられた開孔 4 を介して接続される。接続の方法としては、図 1 に示すように、N R D ガイドの端部を開放終端部 5 a と開孔 4 とを接続する。また、他の方法としては、図 2 の斜視図に示すように誘電体導波管 B の側壁 4 の一部に開孔 7 を形成し、N R D ガイド A 側の開孔 4 と誘電体導波管 B 側の開孔 7 を整合させて接続することにより、N R D ガイド A と誘電体導波管 B とを損失を小さく接続することができる。

【0014】なほ、図 2 の接続方法においては、開孔 7 は、誘電体導波管 B の終端 5 b からの距離 x が、誘電体導波管 B の管内波長の  $1/2$  波長長さ位置に形成されることが望ましい。

【0015】また、誘電体導波管 B 内の誘電体 6 としては、N R D ガイド A における誘電体線路 3 と同程度の誘電率を有する誘電体により形成することにより損失の小さい接続が可能である。

【0016】N R D ガイド A 側の開孔 4 の形状は、N R D ガイドの管内波長の半分以下の長さ (L) と N R D ガイドの誘電体ストリップと同じ程度の幅 (W) を持つ、図 1、図 2 に示すような矩形状の他、円形状、長孔状であってもよい。

【0017】本発明のN R D ガイド A と誘電体導波管 B との接続構造に用いられる誘電体としては、セラミックスの他、有機系誘電体材料、有機-無機複合系誘電体材料などの周知の誘電体材料が用いられる。

【0018】

【実施例】実施例 1

厚さ 1 mm の銅板を 1.8 mm の間隔で平行に置き、断面形状が幅 0.8 mm、高さ 1.8 mm、比誘電率 4.8 の誘電体線路を金層板間に置くことで形成されるN R D ガイドの開放終端部から 3.3 mm の位置に中心を持つ幅 0.8 mm、長さ 1.2 mm の矩形の開孔を金層板に開け、その開孔内には比誘電率 4.8 の誘電体を充填した。

【0019】そして、この開孔に対して、開孔形状と同じ断面形状を持ち、比誘電率が 4.8 の誘電体が金層管内に充填された誘電体導波管を接続した。この構成による接続構造についてネットワークアナライザによってN R D ガイドと誘電体導波管間の伝送特性 (S 21) を測定し、その結果を図 5 に示した。図 5 の結果から明らかのように、約 7.8 GHz において -0.6 (dB) のビ

ークを有する良好な伝送特性を示した。

【0020】実施例 2

実施例 1 の開孔を形成したN R D ガイドに対して、0.6 mm × 1.2 mm の断面形状を持ち、比誘電率が 4.8 の誘電体が充填された誘電体導波管を接続した。接続には、誘電体導波管の終端部と中心位置との距離が 1.34 mm となる側壁にN R D ガイドの開孔と同一形状の開孔を形成し、両開孔を接続した。そして、実施例 1 と同様にして伝送特性を評価し、その結果を図 6 に示した。図 6 に示すように、7.4 ~ 8.0 GHz 領域において、伝送損失が -1.0 dB よりも小さい良好な特性を示した。

【0021】

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明によれば、N R D ガイドと誘電体導波管とをN R D ガイドの導体板の特定箇所に設けた開孔を介して誘電体導波管と接続することにより、低い挿入損失での接続が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明のN R D ガイドと誘電体導波管の接続構造の一例を説明するための分解斜視図である。

【図 2】本発明のN R D ガイドと誘電体導波管の接続構造の他の例を説明するための分解斜視図である。

【図 3】本発明におけるN R D ガイド内の電界分布を説明するための平面図である。

【図 4】本発明における図 1 の接続構造による伝送特性を示す図である。

【図 5】本発明における図 2 の接続構造による伝送特性を示す図である。

【図 6】従来におけるN R D ガイドとマイクロストリップ線路との接続構造を説明するための概略斜視図である。

【符号の説明】

A N R D ガイド

B 誘電体導波管

1, 2 平板導体

3 誘電体線路

4, 7 開孔

5 導体管壁

5 a 開放終端部

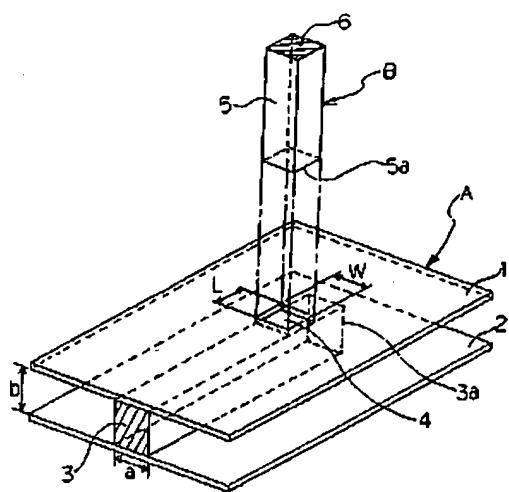
5 b 終端部

6 誘電体

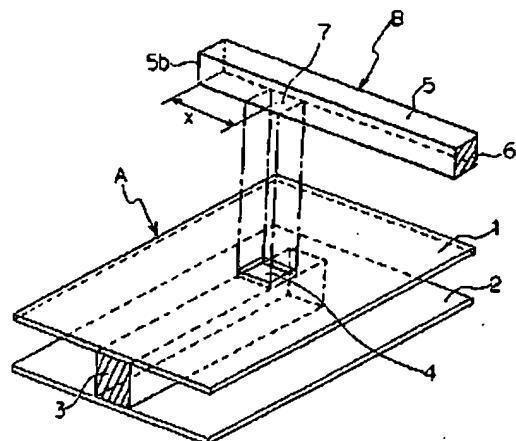
(4)

特開2000-22407

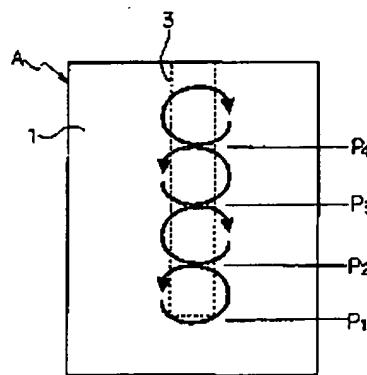
【図1】



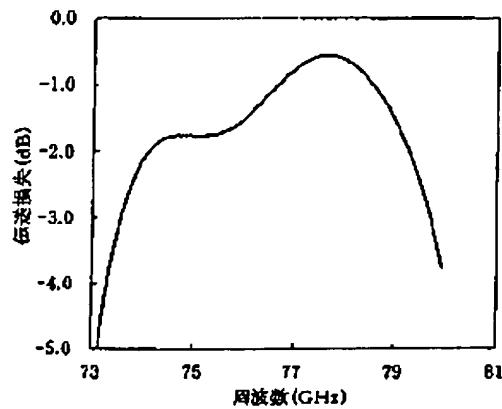
【図2】



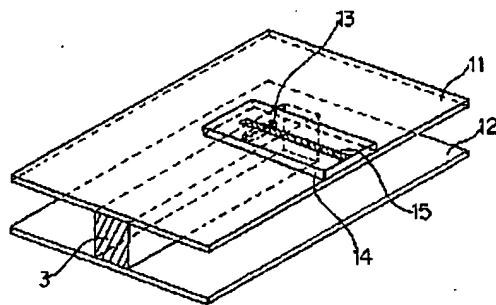
【図3】



【図4】



【図6】



(5)

特開2000-22407

【図5】

